電気学会研究会資料目次

電子デバイス研究会

テーマ「超高速デバイス・回路技術」

〔委員長〕和田恭雄（早稲田大学）

〔副委員長〕益 一哉（東工大）

〔幹 事〕本間哲哉（芝浦工大），荒川太郎（横浜国大）

〔幹事補佐〕大見俊一郎（東工大）

日 時 平成17年3月10日（木）14:00～17:00

平成17年3月11日（金） 9:00～12:00

場 所 NTT水上保養所「紫明荘」（群馬県利根郡水上町湯檜曾 15-1, Tel: 0278-72-3650, JR水上
駅より湯檜曾行きバス10分, 湯檜曾駅前下車）

EDD-05-37 InP HEMTを用いた低消費電力スイッチマトリクスIC

上綱秀樹, 山根康朗, 徳光雅美, 菅原裕彦, 村口正弘（日本電信電話）…………… 1

EDD-05-38 超高速IC用InP HEMTデバイス・プロセス技術

原 直紀, 牧山剛三, 高橋 剛, 今西健治, 多木俊裕, 岡本直哉（富士通研究所）…………… 7

EDD-05-39 ディープサブミクロンInP系 HBT

宮本恭幸（東京工業大学, JST-CREST）

渡辺康弘（東京工業大学）……………13

EDD-05-40 【招待講演】ミリ波帯パッシブ・イメージング技術

水野皓司（東北大学）……………19

EDD-05-41 Sub-10-nm平面型Bulk CMOSにおけるS/D直接トンネル電流特性

若林 整, 江崎達也, 羽根正巳, 阪本利司, 川浦久雄,

五十嵐信行, 竹内 潔, 山本豊二（NEC）

池澤健夫（NEC情報システムズ）……………25

EDD-05-42 高性能・微細ひずみSOI-MOSFET

沼田敏典, 入沢寿史, 手塚 勉, 古賀淳二, 平下紀夫, 白田宏治（MIRAI-ASET）

豊田英二（東芝セラミックス）

宮村佳児（コマツ電子金属）

田邊顕人, 杉山直治（MIRAI-ASET）

高木信一（MIRAI-AIST, 東京大学）……………29

EDD-05-43 ソースビア接地構造を用いたSi基板上350V/150A AlGaIn/GaNパワーHFET
引田正洋，柳原 学，中澤一志，上野弘明，廣瀬 裕，
上田哲三，上本康裕，田中 毅，上田大助（松下電器産業）
江川孝志（名古屋工業大学）……………35

EDD-05-44 アンダープAlGaIn/GaN HEMTを用いた1.9GHz動作SPDTスイッチ
広瀬真由美，高田賢治，蔵口雅彦，佐々木忠寛，鈴木 隆，津田邦男（東芝）……………39

共 催 電気学会 電子デバイス委員会「超高速デバイス・回路技術」調査専門委員会